

КТ501А

Транзисторы кремниевые эпитаксиально-планарные структуры р-п-р усилительные.
Область применения: усилители низкой частоты, операционные, дифференциальные и импульсные усилители, преобразователи.

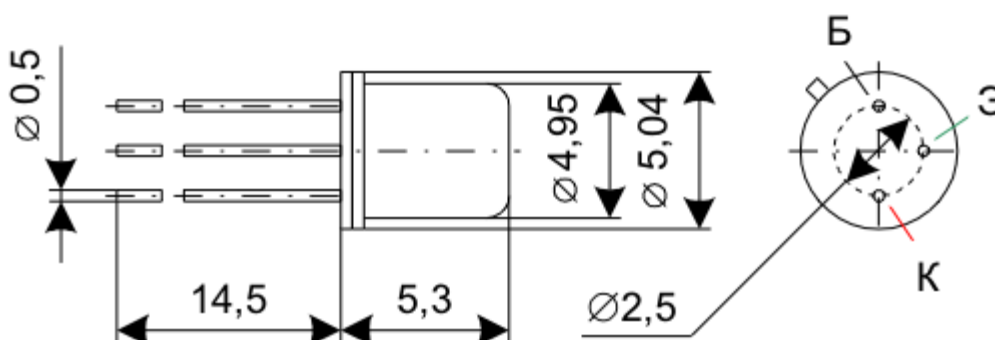
Выпускаются в металлостеклянном корпусе с гибкими выводами.

Тип прибора указывается на корпусе.

Масса транзистора не более 0,6 г.

Тип корпуса: КТ-1-7 (ТО-18).

Технические условия: аА0.336.064 ТУ.



Основные технические характеристики транзистора КТ501А:

- $h_{21э}$ - Статический коэффициент передачи тока в схеме ОЭ при $U_{кэ}=1$ В, $I_{к}=30$ мА: 20... 60;
- $f_{гр}$ - Граничная частота коэффициента передачи тока в схеме ОЭ: не менее 5 МГц;
- $I_{кэо}$ - Обратный ток коллектор-эмиттер при $U_{кэр}=15$ В, $R_{бэ}=10$ кОм : не более 1 мкА;
- $C_{к}$ - Емкость коллекторного перехода: не более 50 пФ;
- $U_{кб}$ и $U_{кэг\max}$ - Максимальные напряжения коллектор-база и коллектор-эмиттер при $R_{бэ}=10$ кОм: 15 В;
- $U_{эб\max}$ - Максимальное напряжение эмиттер-база: 10 В;
- $I_{к\max}$ - Максимально допустимый постоянный ток коллектора: 300 мА;
- $I_{к\text{ и }I_{к\max}}$ - Максимально допустимый импульсный ток коллектора: 500 мА;
- $P_{к\max}$ - Постоянная рассеиваемая мощность коллектора: 350 мВт;
- $t_{п}$ - Температура р-п перехода: не более 150°C;
- $t_{окр}$ - Температура окружающей среды: -60...+125°C.